

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0201U004849

Державний реєстраційний номер: 0197U003268

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-04-2001

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження адсорбційних та емісійних властивостей складних плівок на W, характерних для металевопористих катодів.

Початок етапу: 01.1997

Закінчення етапу: 12.2000

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2661468

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вплив електронної підсистеми на формування складу кристалів напівпровідникових сполук.

Назва роботи англійською:

The influence of the electron subsystem on the forming of the structure of the semiconductor crystals.

Реферат українською:

Досліджено вплив стану електронної підсистеми на випаровування та склад приповерхневого шару кристалів типу A2B6 та A3B5, а також складних кристалів ніобату літію. Показано, що основні положення розробленої раніше електронної теорії випаровування та формування приповерхневого складу бінарних напівпровідникових сполук з іонним зв'язком при прогріванні у вакуумі справедливі і у випадку кристалів із слабкою полярністю та складних кристалів. Досліджено адсорбційно-емісійні властивості складних плівок, характерних для металевопористих катодів. Проведено аналіз можливостей використання поверхнево-бар'єрних структур на основі надтонких плівок металу-кремній у якості напівпровідникових газових сенсорів.

Реферат англійською:

The influence of the condition of the electronic subsystem to evaporation and structure of the near-surface layer of the crystals such as A2B6 and A3B5, and also composite crystals of the LiNbO3 was studied. It is shown, that the original positions of the electronic theory of the evaporation and formation of the near-surface structure of the binary semiconductor crystals with an ion bonding at their heating in the vacuum, has been designed before, are also used in case of the crystals with feeble polarity and composite crystals. The adsorption and emissive properties of composite films, which are referred to the dispenser cathodes are investigated. The analysis of the possibility of using superficially-barrier structures, based on the thin films of the metal - silicon composition as the gas sensors is carried out.

Індекс УДК: 533.9.01, 621.385.7

Коди тематичних рубрик: 29.27.01

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ільченко В.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

